

하이닉스, 40나노 DDR D램 인증

Intel, 노트북용 4GB 및 데스크탑용 2GB 모듈도 ... 11월부터 양산

하이닉스반도체가 11월부터 양산을 시작한 40나노급 2기가비트(Gb) DDR3 D램이 인텔(Intel)의 인증을 받았다.

D램 외에 노트북용 4기가바이트(GB) 모듈(SODIMM), 데스크탑용 2GB 모듈(UDIMM)도 인텔 인증을 획득했다.

인텔 인증은 세계시장의 대부분을 차지하는 인텔 기반의 컴퓨팅 시스템에서 D램이 정상적으로 작동하고 호환성이 있는지 객관적으로 검증하는 것으로 인증제품만 인텔의 기술 지원을 받을 수 있어 수요처에게 품질이 인정된 제품을 바로 공급할 수 있게 된다.

하이닉스가 11월부터 양산에 들어간 40나노급 2Gb DDR3 D램은 기존 50나노급보다 생산성이 60% 이상 높고, 1.5V·1.35V 저전압과 1133Mbps의 데이터 전송 속도를 구현했다.

최대 1867Mbps의 데이터 전송 속도로 16개 정보입출구(I/O)를 통해 초당 영화 2-3편에 해당하는 3.7GB의 데이터를 처리할 수도 있다.

하이닉스는 2100년 말까지 D램 생산량의 70%를 DDR3로 전환하고, DDR3 D램 중 2Gb 제품 비중을 약 40% 선까지 높일 계획이다.

또 서버를 중심으로 고성능 제품에는 2기가비트 제품을, PC를 중심으로는 1기가비트 제품을 공급하는 등 차별화된 방식으로 저전력 DDR3 제품을 공급할 예정이다.

하이닉스 마케팅본부 김지범 전무는 “1기가비트 제품에서 고성능 서버를 중심으로 2기가비트 제품으로 빠르게 전환되고 있다”며 “2009년까지 서버용 모듈(RDIMM)도 인텔 인증을 받아 1기가비트 및 2기가비트 제품 모두에서 업계 최고의 성능을 확보할 것”이라고 말했다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재·재배포 금지>

<화학저널 2009/11/20>